## 补充材料

## 球形双曲色散超材料腔的多重窄带回音廊模式 及透明显示应用\*

李艳<sup>†</sup> 任思萌 褚博 燕汝江 于群星 孙辉 邵立 钟发成<sup>\*</sup> (郑州航空工业管理学院材料学院,郑州 450046)

我们减少最外层介质层,对 7 层银/介质交替组成的球形双曲色散超构材料 (HMM) 腔进行研究,这里我们设银层厚度为 *d*=5nm,介质层厚度为 *s*=4nm, 从内到外介质层折射率分别为 *n*1=1.8, *n*2=1.45, *n*3=1.45,结构的散射效率谱, 如图 S1 (a) 所示。发现这里的 7 层银/介质交替组成的 HMM 腔和正文图 1 中 8 层银/介质交替组成的 HMM 腔都只有偶极电分量在所示波段起主要贡献,准静 态近似成立。通过 8 层银/介质交替组成的 HMM 腔和 7 层银/介质交替组成的 HMM 腔进行对比,发现 HMM 腔所激发的电共振(TM<sub>n,m</sub>)个数仅与金属层的数目 相关。因此,当考虑到彩色透明显示的应用(构建红绿蓝波段的三重窄带共振), 可以将 HMM 腔简化到三层银和两层介质层,即可激发出三个窄带的回音廊模式。

可以清楚地看到,随着第一介质层折射率(n1)的增大,如图 S2(a)所示,TM1,1 的共振位置几乎不发生变化,TM1,2、TM1,3 均发生红移。且 TM1,2 模式强度减 弱,TM1,1 模式强度逐渐增强。随着第二介质层折射率(n2)的增大,如图 S2(b)所示, TM1,2 共振位置几乎不发生变化,TM1,1 向更长波长移动,且模式强度逐渐减弱, TM1,3 模式强度逐渐增强。

在图 S3(a)中进一步固定 n2=1.45 时,可以清楚地看到第一层介质折射率 n1 对 TM1,1, TM1,2,, TM1,3 三个模式的影响。当 n1>1.4 时, TM1,3 共振才会出现在

可见光波段,且TM<sub>1,1</sub>,TM<sub>1,2</sub>,TM<sub>1,3</sub>均随着 n<sub>1</sub>的增大,发生红移。但当 n<sub>1</sub>>2.2 时TM<sub>1,3</sub>共振强度明显变弱;在图 S3(b)中可以清楚地看到当第二层介质折射率 n<sub>2</sub>增大时,TM<sub>1,2</sub>,TM<sub>1,3</sub>模式红移不明显,但TM<sub>1,1</sub>模式发生剧烈的红移。当 n<sub>2</sub>>1.8 时TM<sub>1,1</sub>模式红移到可见光波段以外,且共振强度明显变弱。在图 S3(c)中可以 清楚地看到当第一层银壳层厚度 d<sub>1</sub>增大时,TM<sub>1,1</sub>,TM<sub>1,3</sub>均随着 d<sub>1</sub>的增大,发 生红移,TM<sub>1,2</sub>模式先红移再蓝移,且共振强度减弱。在图 S3(d)中可以清楚地看 到当第一层介电层厚度 s<sub>1</sub>增大时,TM<sub>1,1</sub>,TM<sub>1,2</sub>均随着 s<sub>1</sub>的增大,发生红移, 当 s<sub>1</sub>>2 时,TM<sub>1,3</sub>共振才会出现在可见光波段,且共振强度逐渐增强。



图 S1 (a) 7 层银(d=5nm)/介质层(s=4 nm,  $n_1=1.8$ ,  $n_2=1.45$ ,  $n_3=1.45$ )交替包裹组成的球形 HMM 腔的散射谱,黑线代表偶极电贡献 ( $a_1$ ),红线代表四极电贡献 ( $a_2$ )。为了更清楚地显示电四 极子的贡献,将其散射效率值扩大了 50 倍; (b)结构在 TM<sub>1,1</sub>模式共振波长  $\lambda\approx1268$ nm 处的 电场强度分布图;(c) HMM 腔在 TM<sub>1,2</sub>模式共振波长  $\lambda\approx769$ nm 处的电场强度分布图;(d) HMM 腔在 TM<sub>2,1</sub>模式共振波长  $\lambda\approx792$ nm 处的电场强度分布图;(e) HMM 腔在 TM<sub>2,2</sub>模式共振波长  $\lambda\approx534$ nm 处的电场强度分布图。



图 S2 (a)球形双曲色散腔在改变介质层折射率 n<sub>1</sub>=1.5-1.9 时的散射效率谱; (b)球形双曲色散腔在改变介质层折射率 n<sub>2</sub>=1.3-1.7 时的散射效率谱。



图 S3 HMM 腔中 *R<sub>in</sub>*=5nm, *s*<sub>2</sub>=9nm, 和 *d*<sub>2</sub>=8nm 固定情况下, (a)进一步固定 *s*<sub>1</sub>=4nm, *d*<sub>1</sub>=5nm, *n*<sub>2</sub>=1. 45,介质折射率 *n*<sub>1</sub>从 1.0 到 3.0 变化时,HMM 腔的散射效率变化谱;(b)进一步固定 *s*<sub>1</sub>=4nm, *d*<sub>1</sub>=5nm, *n*<sub>1</sub>=1.8,当介质折射率 *n*<sub>2</sub>从 1.0 到 3.0 变化时,HMM 腔的散射效率变化 谱;(c)进一步固定 *n*<sub>1</sub>=1.8, *n*<sub>2</sub>=1. 45, *s*<sub>1</sub>=4nm,银壳层厚度 *d*<sub>1</sub>从 0 nm 到 10 nm 变化时,HMM 腔的散射效率变化谱;(d)进一步固 *n*<sub>1</sub>=1.8, *n*<sub>2</sub>=1. 45, *d*<sub>1</sub>=5nm,介质层厚度 *s*<sub>1</sub>从 0nm 到 10nm 变化时 HMM 腔的散射效率变化谱。